基于第一性原理的新型光伏材料 HgIn₂S₄ 的光电性能研究

常秦乐, 尹媛*

宝鸡文理学院,物理与光电技术学院 陕西宝鸡

【摘要】尖晶石 HgIn₂S₄ 因其同时具有四面体和八面体结构而备受关注。本文研究了它的晶体结构,稳定性和光电性质。研究结果表明,HgIn₂S₄ 具有很好的动力学热稳定性,同时具有合适的带隙和较高的光吸收系数,可被用于太阳能电池吸收层。

【关键词】光伏材料;尖晶石;第一性原理计算;光电性能

【基金项目】宝鸡文理学院 2024 年研究生创新科研项目,名称:尖晶石 HgIn₂S₄ 缺陷性质的理论研究(编号: YJSCX24YB40)

【收稿日期】2025年4月6日 【出刊日期】2025年6月11日 【DOI】10.12208/j.jccr.20250007

Research on the optoelectronic properties of a new photovoltaic material HgIn2S4 based on first principles

Qinle Chang, Yuan Yin*

School of Physics and Optoelectronic Technology, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji, Shaanxi

[Abstract] Spinel HgIn₂S₄ has attracted much attention due to its simultaneous tetrahedral and octahedral structures. This article investigates its crystal structure, stability, and optoelectronic properties. The research results indicate that HgIn₂S₄ has good kinetic thermal stability, suitable bandgap, and high light absorption coefficient, and can be used as an absorber layer for solar cells.

[Keywords] Photovoltaic materials; Spinel; First principles calculations; Optoelectronic properties

1 引言

大力开发并利用太阳能是解决我国能源短缺和环 境污染,实现"双碳"目标的重要途径。近年来,有机 一无机卤化钙钛矿 CH₃NH₃PbI₃ 因其优良的光吸收系 数(~10⁵ cm⁻¹)、较长的载流子扩散长度(> 1µm)、较高 的载流子迁移率、可调的直接带隙、良好的缺陷容忍性 和低的生产成本,在太阳能电池方面具有重要的应用 价值^[1-9]。然而,该材料在应用方面依然有一些关键性 问题亟待解决,主要包括:(1)与环境的相容性问题。 由于 CH₃NH₃PbI₃ 中的阳离子 Pb²⁺具有毒性会对环境 造成极大的污染,目前主要通过元素替换法来寻找不 含 Pb 的材料,但相应也会降低电池的效率。(2)电池的 稳定性问题^[10]。CH₃NH₃PbI₃很容易受水、光、热、以 及有机分子等因素的影响发生分解而造成电池效率降 低或失效。这是因为有机阳离子 CH₃NH₃⁺¹的吸光性和 卤族阴离子 I⁻¹的吸湿性使得 CH₃NH₃PbI₃ 在空气中不 仅遇水易降解,而且在温度超过 85℃或光照时也很容 易分解成次元相 CH₃NH₃PbI₃和 PbI₂,不再具有钙钛矿 的优良特性,因而如何提高材料本身的稳定性就显得 至关重要。因此,如何设计并得到一种或几种可以同时 兼顾稳定性和优良光电性能的新型太阳能电池材料就 成为当前光伏领域的研究关键。

钙钛矿材料的结构通式为 ABX3, 早期研究表明, 其优良的吸光性能、优异的电荷传输速率以及较长的 载流子扩散长度等独特性能主要归因于晶体中的 PbI2 八面体构型,该构型具有六配位晶体结构特征。此外, 先前的研究还发现,第二代薄膜太阳能电池材料,如硅、 碲化镉以及砷化镓等,均展现处非常好的稳定性,而这 类材料均具有四面体晶体结构特征。在材料设计与筛 选的过程中,我们发现尖晶石材料的晶体结构刚好满 足上述两方面的要求,即兼具八面体和四面体构型,其 化学通式为 AB2X4。材料的晶体结构是以 X 离子的面

作者简介: 常秦乐, 男, 硕士研究生, 研究方向为光伏材料的物性研究

^{*}通讯作者: 尹媛, 女, 副教授, 博士, 硕士生导师, 研究方向为计算凝聚态物理

心立方密堆积为基本框架, A 位离子和 B 位离子分别 占据不同的间隙位置。根据 A 位和 B 位离子的占据情 况,可以分为正尖晶石结构、反尖晶石结构和双尖晶石 结构^[11]。在本文中,我们采用第一性原理计算方法研究 了正尖晶石材料 HgIn₂S₄的晶体结构和光电性能,发现 它具有非常好的稳定性,同时表现出了优异的光伏性 能,具有合适的带隙已经非常好的缺陷容忍性,通过计 算光吸收系数,证明其具有良好的光学性能,适合用于 太阳电池的吸收层材料。

2 计算方法

该工作是基于 VASP 密度泛函理论展开的,采用 了标准的投影增强波方法来处理内部原子中离子—电 子间的相互作用交换关联势采用的是广义梯度近似 GGA 下的 PBE 赝势^[12-14]。我们设置平面波基本截止能 量为 550 eV,并采用 3×3×3 的K 点网格进行结构弛豫 计算。原子的位置被完全放松,直到作用在每个原子上 的赫尔曼-费曼(HF)力小于 0.02 eV/Å 为止。我们优化 的体相 HgIn₂S₄ 的晶格常数为 10.95 Å,与实验结果 10.94 Å 基本一致。声子输运性质是由基于声子玻尔兹 曼输运理论的 BTE 程序获得。电子输运中声子色散是 基于 Phonopy 软件包展开的,使用 4×4×4 网格的 K 点 计算声子谱。

3 结果与分析

3.1 HgIn₂S₄的晶体结构

体相 HgIn₂S₄属于立方晶系,空间群为 Fd-3m,其 晶体结构如图 1(a)所示。其中,Hg²⁺与4 个等效的 S²⁻ 原子结合形成 HgS₄ 的四面体,In³⁺与6 个等效 S²⁻原子 结合形成 InS₆ 的八面体 Hg 和 In 元素与S 配位,分别 是四配位的四面体结构和六配位的八面体结构。而金 属与S之间具有较大的电负性,有助于形成具有高缺 陷容忍度的离子晶体,即高晶体对称性。为了进一步验 证该材料的稳定性,我们计算了 HgIn₂S₄在 0K 下的声 子谱线图,结果如图 3.1 (b)所示。在热力学稳定条件 下,材料低频区显示没有虚频,这证明了该材料在热力 学上是稳定的。从声子态密度图看出高频区的光学支 由S和 In 原子共同振动贡献,低频区的光学支由 Hg 原子振动贡献。



图 1 HgIn₂S₄: (a) 晶体结构图,其中灰色、浅蓝色和黄色分别代表 Hg、In 和 S 原子,(b) 0 K 时的声子谱(蓝色实线)

3.2 HgIn₂S₄的电学性质

由于合适的带隙对光伏材料至关重要,这里我们 对 HgIn₂S₄的电学性质做了详细的计算,包括能带和态 密度。在能带图中,带边位置(导带底和价带顶)对材 料的性质影响较为明显,而绝大多数金属硫化物的导 带底主要是由金属的 *s* 轨道贡献的,尤其是对于主量 子数较大的最外层*s* 轨道,CBM 态表现出更强的非局 域特性。相反,它们的价带顶是由较深且局域化更高的 S-3*p* 轨道组成的,使得空穴掺杂变得极其困难,导致 空穴具有较大的有效质量。考虑到 HgIn₂S₄ 含有过渡金 属元素,PBE 的计算结果可能会低估带隙值,这里, 我们将分别采用 PBE 和 HSE06 的方法计算其能带结 构,如图 2.1(a)所示,其中蓝色实线代表 PBE 的结果, 而红色实线代表杂化泛函 HSE06 的结果。从 HSE06 的 结果可以看出来,价带顶位于-0.22 eV 的位置,导带底 位于 0.98 eV 的位置,具有太阳能电池材料吸收层适合 的带隙值 1.20 eV。从能带图可见,导带底和价带顶不 在同一高对称点,故为间接带隙,这是因为在周期性晶 体结构中 Hg-6s 轨道相对扩散,从而在倒格子空间中 表现较大的色散。

此外,我们还计算了 HgIn₂S₄ 的态密度 DOS,如 图 2(b)所示。从总的态密度 TDOS 和分波态密度 PDOS 可以看出,价带主要来自于 S-3*p*、Hg-5*d*和 In-4*d*轨道 的杂化,其中 S-3*p*轨道做主要贡献,而局域化的 Hg-5*d*和 In-4*d*轨道的贡献小于 S-3*p*轨道。导带主要由非 局域化的 Hg-6*s*和 In-5*s*轨道组成,这导致导带底向下 弯曲。边缘价带顶处主要由 Hg-6*s*和 In-5*s*轨道耦合, 而导带底主要由 S-3*p*轨道贡献。由于在 HgIn₂S₄中, In 原子相对 S 原子具有较低的电负性,它们之间具有

很强的库仑相互作用,因此具有明显的离子特性。



图 2 HgIn₂S₄: (a) 能带结构图, (b) 总态密度(TDOS)和部分态波密度(PDOS)

3.3 HgIn₂S₄的光学性质

HgIn₂S₄作为一种典型的三元硫属化物,其光学特 性与电子能带结构密切相关。图 3 给出了 HgIn₂S₄基于 第一性原理计算得到的光学性质,其中图 3(a)为介电 函数,包括实部(红色曲线)和虚部(蓝色曲线)。从 实部可以看出,其在可见光波段(400-700 nm)呈现显 著色散行为,初始值约 6.8(400 nm),随波长增加逐 渐降低至 5.2 (700 nm),表明材料在短波长区域具有 更强的极化响应。而虚部在 500 nm 附近出现明显吸收 峰,对应带隙电子跃迁过程。介电常数虚部在可见光区 域大于 3,表明 HgIn₂S₄具有显著的光和物质之间的相 互作用,结合其高吸收系数和适中带隙,可用于催化反 应(如水解制氢)、薄膜太阳能电池吸收层、以及宽谱 光电探测器等方面。



图 3 HgIn₂S₄: (a) 介电函数, (b) 光吸收谱

此外,图 3 (b) 给出了 HgIn₂S₄ 的光吸收谱。其光 吸收系数在带边附近 (650 m eV) 呈现陡峭上升趋势。 当光子能量高于 1.6 eV 时,光吸收系数超过 10⁴ cm⁻¹, 显示出强烈的光捕获能力,这与 In-S 八面体层中的 *d*-*p* 轨道之间很强的杂化耦合有关。

4 结论

本文研究了新型光伏材料 HgIn₂S₄的晶体结构,热 动力学稳定性以及光电性质。研究结果表明,HgIn₂S₄ 兼具四面体和八面体的晶体构型,具有稳定的结构和 较好的光伏性能,其中 HSE06 计算的带隙值为 1.2 eV, 同时具有较高的光吸收系数,符合光伏材料对带隙和 光吸收的要求,可被用作太阳能电池吸收层材料。

参考文献

- ZH Guan, LL Fu, L Chen, et al. Greatly enhanced ultrafast optical absorption nonlinearities of pyridyl perovskite nanocrystals axially modified by star-shaped porphyrins. Chem. Sci. 16 (2025).
- [2] M Zhang, C Wu, M Yin, et al. High Efficiency Tin Halide Perovskite Solar Cells with Over 1 Micrometer Carrier Diffusion Length. Adv. Funct. Mater. 2410772 (2024).

- [3] J Lim, MT Hörantner, N Sakai, et al. Elucidating the Long-Range Charge Carrier Mobility in Metal Halide perovskite Thin Films. Energ. Environ. Sci. 12, 169 (2019).
- [4] ZY Cai, JC Zhu, CY Ding, et al. Compositional engineering for lead-free antimony bismuth alloy-based halide perovskite solar cells, J. Semicond. 46(5), 052803 (2025).
- [5] W-J Yin, T Shi, Y Yan. Unusual Defect Physics in CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cell Absorber. Appl. Phys. Lett. 104, 063903 (2014).
- [6] Y Rong, Y Hu, A Mei, et al. Challenges for Commercializing Perovskite Solar Cells. Science 361, eaat8235 (2018).
- [7] B Yu, J Shi, S Tan, et al. Efficient (>20 %) and Stable All-Inorganic Cesium Lead Triiodide SolarCell Enabled by Thiocyanate Molte Salts. Angew. Chem. Int. Ed. 60, 13436 (2021).
- [8] J Chen, J Wang, X Xu, et al. Efficient and Bright White Light-Emitting Diodes Based on Single-Layer Heterophase Halide Perovskites. Nat. Photonics 15, 238 (2021).
- [9] G Chen, J Feng, H Gao, et al. Stable α-CsPbI3 Perovskite Nanowire Arrays with Preferential Crystallographic

Orientation for Highly Sensitive Photodetectors. Adv. Funct. Mater. 29, 1808741 (2019).

- [10] H Zhu, S Teale, MN Lintangpradipto, et al. Long-term operating stabilityin perovskite photovoltaics. Nat. Rev. Mater. 8, 569 (2023).
- B Suleiman, U Adam, B Francesco, et al. An introduction to perovskites for solar cells and their characterization[J]. Energy Report., 8:89-106 (2022)
- [12] G Kresse, J Furthmüller, Efficiency of Ab-initio Total Energy Calculations for Metals and Semiconductors Using a Plane-wave Basis Set. Comp. Mater. Sci. 6, 15-50 (1996)
- [13] G Kresse, D Joubert, From Ultrasoft Pseudopotentials to the Projector Augmented-Wave Method. Phys. Rev. B, 59, 1758-1775 (1999)
- [14] P E Blöchl, Projector Augmented-Wave Method. Phys. Rev.
 B, 50, 17953-17979. (1994)

版权声明:©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

$$\textcircled{OPENACCESS}$$